







 	<h2 style="color: red;">FQB4N20LTM</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQB4N20LTM</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 3.8A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB4N20LTM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQB4N20LTM</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.8A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	32363 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.35 Ohm @ 1.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.2nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	310pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQB4N20LTM ist neu im Original, Suche FQB4N20LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB4N20LTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB4N20LTM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FQB4N20TM</b> VB FQB4N20TM VB	 <b>FQB4N20L</b> VB FQB4N20L VB	 <b>FQB4N25TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3.6A D2PAK	 <b>FQB4N25TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3.6A D2PAK
 <b>FQB47P06TM_AM002</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A D2PAK	 <b>FQB4N20LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A D2PAK	 <b>FQB4N20</b> VB FQB4N20 VB	 <b>FQB4N20TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.6A D2PAK

### heiße Teile

Mehr

FQB34P10TM_F085	FQB3N25TM	FQB3N25TM	FQB3N30TM	FQB3N30TM
FQB3N40TM	FQB3N40TM	FQB3N60C	FQB3N80TM	FQB3N80TM
FQB3N90TM	FQB3N90TM	FQB3P20TM	FQB3P20TM	FQB3P50TM
FQB3P50TM	FQB44N10	FQB44N10TM	FQB44N10TM	FQB46N15
FQB46N15TM	FQB47P06	FQB47P06TM	FQB4N20L	FQB4N20LTM
FQB4N20TM	FQB4N20TM	FQB4N25TM	FQB4N25TM	FQB4N20TM
FQB4N50TM	FQB4N50TM	FQB4N60C	FQB4N80TM	FQB4N80TM
FQB4N90TM	FQB4N90TM	FQB4P25TM	FQB4P25TM	FQB50N03
FQB50N06	FQB50N06C	FQB50N06L	FQB50N06LTM	FQB50N06LTM
FQB50N06M	FQB50N06TM	FQB50N06TM	FQB50N06TM-NL	FQB55N06TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited